



	<h2>SIA456DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA456DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 2.6A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA456DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8261 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA456DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 2.6A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8261 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 2.6A (Tc) 3.5W (Ta), 19W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.38 Ohm @ 750mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIA456DJ-T1-GE3TR

SIA456DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA456DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA456DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA456DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA459EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC70</p>	 <p>SIA453EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 24A PPAK SC-70-6</p>	 <p>SIA461DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA4528-100K DELTA SIA4528-100K DELTA</p>
 <p>SIA4528-470K DELTA SIA4528-470K DELTA</p>	 <p>SIA459EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC70</p>	 <p>SIA453EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 24A PPAK SC-70-6</p>	 <p>SIA461DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIA432DJ-T1-GE3	↔ SIA432DJ-T1-GE3	⇒ SIA433EDJ	D SIA433EDJ-T1-GE3	↔ SIA433EDJ-T1-GE3
↳ SIA436DJ-T1-GE3	⊛ SIA436DJ-T1-GE3	D SIA443DJ-T1-GE3	⇒ SIA443DJ-T1-GE3	↔ SIA444DJ-T1-GE3
⊛ SIA444DJ-T1-GE3	↳ SIA445EDJ-T1-GE3	⊛ SIA445EDJ-T1-GE3	↔ SIA447DJ-T1-GE3	↔ SIA447DJ-T1-GE3
D SIA448DJ-T1-GE3	⊛ SIA448DJ-T1-GE3	↳ SIA449DJ-GE3	⊛ SIA450DJ-T1-GE3	↔ SIA450DJ-T1-GE3
⇒ SIA4528-100K	↔ SIA4528-330K	⊛ SIA4528-470K	↳ SIA453EDJ-T1-GE3	↔ SIA453EDJ-T1-GE3
↔ SIA456DJ-T1-GE3	⇒ SIA483DJ-T1-GE3	D SIA483DJ-T1-GE3	⊛ SIA513DJ-T1-E3	↳ SIA517DJ-T1-GE3
⊛ SIA517DJ-T1-GE3	D SIA517DJ-T4-GE3	⇒ SIA519EDJ-T1-GE3	↔ SIA519EDJ-T1-GE3	↔ SIA533EDJ-T1-GE3
↳ SIA533EDJ-T1-GE3	⊛ SIA778DJ-T1-GE3	↔ SIA778DJ-T1-GE3	⇒ SIA811ADJ-T1-GE3	↔ SIA811ADJ-T1-GE3
⊛ SIA811DJ-T1	↳ SIA811DJ-T1-E3	⊛ SIA811DJ-T1-E3	D SIA811DJ-T1-GE3	↔ SIA811DJ-T1-GE3
↔ SIA813DJ-T1-GE3	⊛ SIA813DJ-T1-GE3	↳ SIA814DJ-T1-GE3	⊛ SIA814DJ-T1-GE3	↔ SIA906EDJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited